(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Mai 2002 (30.05.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/43243 A1

H03H 9/58 (51) Internationale Patentklassifikation⁷:

PCT/EP01/12825 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. November 2001 (06.11.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 24. November 2000 (24.11.2000) DE 100 58 339.3

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(nur für *US*): AIGNER, (75) Erfinder/Anmelder Robert [AT/DE]; Einsteinstr. 104/8-13, 81675 München (DE). MARKSTEINER, Stephan [AT/DE]; Cramer-Klett-Strasse 33, Neubiberg (DE). 85579

NESSLER, Winfried [AT/DE]; Ulrich von Huttenstrasse 24, 81739 München (DE). ELBRECHT, Lüder [DE/DE]; Theodor-Dombart-Strasse 1, 80805 München (DE).

(74) Anwälte: GINZEL, Christian usw.; Zimmermann & Partner, Postfach 330 920, 80069 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

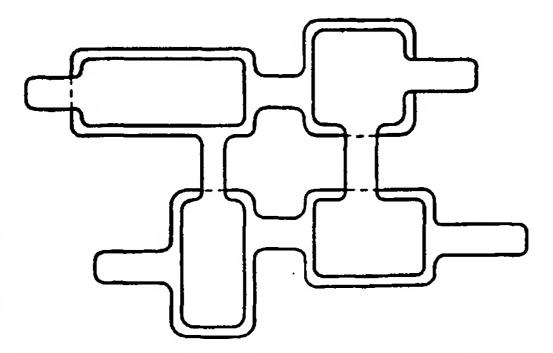
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: BULK ACOUSTIC WAVE FILTER

(54) Bezeichnung: BULK-ACOUSTIC-WAVE-FILTER



(57) Abstract: The invention relates to bulk acoustic wave filters comprising at least two bulk acoustic wave resonators, each of these comprising at least one first electrode, a piezoelectric layer and a second electrode. At least two of the bulk acoustic wave resonators have effective resonator surfaces which differ in their surface form and/or surface content. The inventive design of the bulk acoustic wave resonators enables optimal suppression of interference modes without influencing the impedance level of the filter.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben werden Bulk-Acoustic-Wave-Filter mit wenigstens zwei jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste

02/43243 Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst. Wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren weisen effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Durch die beschriebene Gestaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren lassen sich Störmoden optimal unterdrücken, ohne dass dabei das Impedanzniveau des Filters beeinflusst wird.



i

1

Beschreibung

Bulk-Acoustic-Wave-Filter

5

10

15

20

Die Erfindung betrifft Bulk-Acoustic-Wave-Filter.

Elektrische Filter, die aus Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren oder Stacked-Crystal-Filter aufgebaut sind, werden üblicherweise als Bulk-Acoustic-Wave-Filter bezeichnet.

Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren bestehen typischerweise aus zwei Elektroden und einer piezoelektrischen Schicht, die zwischen den beiden Elektroden angeordnet ist. Ein solcher Stapel aus Elektrode 1 / Piezoschicht / Elektrode 2 wird auf einem Träger angeordnet, der die akustische Welle reflektiert (M. Kenneth, G. R. Kline, K. T. McCarron, High-Q Microwave Acoustic Resonatores and Filters, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 41, No. 12, 1993).

Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen BulkAcoustic-Wave-Resonator. Grundsätzlich wäre die Verwendung
einer Konfiguration ausschließlich bestehend aus Elektrode 1
/ Piezoschicht 3 / Elektrode 2 erstrebenswert. Allerdings
weist eine solche Anordnung eine zu geringe Stabilität auf.
Daher wird die Anordnung auf ein Substrat 4 aufgebracht, was
aber mit dem Nachteil verbunden ist, dass die Schallwellen in
das Substrat 4 eindringen und dadurch Störungen verursacht
werden. Das Substrat 4 sollte also neben einer mechanischen
Trägerfunktion gleichzeitig eine möglichst gute akustische
Isolation bereitstellen. Die Figur 1 zeigt einen akustischen
Spiegel, der aus einem Substrat 4 und einer Abfolge von zwei
low-Z- 5 und zwei high-Z- 6 Schichten besteht.

35

30

Stacked-Crystal-Filter bestehen im allgemeinen aus zwei piezoelektrischen Schichten und drei Elektroden. Diese

2

insgesamt fünf Elemente bilden eine Sandwich-Struktur, wobei jeweils eine piezoelektrische Schicht zwischen zwei Elektroden angeordnet ist. Die mittlere der drei Elektroden wird dabei in der Regel als Erdungselektrode verwendet.

5

10

15

20

25

30

35

1

Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch einen Stacked-Crystal-Filter. Der Stacked-Crystal-Filter besteht aus einem Substrat 7, einer Membran 8, einer ersten, unteren Elektrode 9, einer ersten, unteren piezoelektrischen Schicht 10, einer zweiten, oberen piezoelektrischen Schicht 11, einer zweiten mittleren Elektrode 12 und einer dritten, oberen Elektrode 13. Die mittlere Elektrode 12 ist über einem Teil der unteren piezoelektrischen Schicht 10 und der Membran 8 angeordnet, die obere piezoelektrische Schicht 11 ist über Teilen der mittleren Elektrode 12 und der unteren piezoelektrischen Schicht 10 angeordnet und die dritte, obere Elektrode 13 ist über der oberen piezoelektrischen Schicht 11 angeordnet. Die zweite Elektrode 12 dient als Erdungselektrode. Das Substrat 7 weist einen Hohlraum 14 auf, der dazu dient, die akustischen Schwingungen der piezoelektrischen Schichten zu reflektieren.

Die Reflexion der akustischen Schwingungen wird somit entweder mit Hilfe eines akustischen Spiegels oder mit Hilfe eines Hohlraums erreicht. Ein akustischer Spiegel wurde oben im Zusammenhang mit einem Bulk-Acoustic-Wave-Resonator beschrieben, während die Reflexion der akustischen Schwingungen durch einen Hohlraum für einen Stacked-Crystal-Filter gezeigt wurde. Selbstverständlich ist aber auch die umgekehrte Kombination möglich, also ein Bulk-Acoustic-Wave-Resonator mit einem Hohlraum im Substrat genauso wie ein Stacked-Crystal-Filter mit einem akustischen Spiegel.

Die piezoelektrischen Schichten sind in der Regel aus Aluminiumnitrid aufgebaut. Als Material für die Elektroden werden häufig Aluminium, Aluminium-enthaltende Legierungen, Wolfram, Molybdän oder Platin verwendet. Als Substratmaterial

3

kann z.B. Silizium, Galliumarsenid, Glas oder eine Folie verwendet werden.

Wie oben bereits erläutert weist jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator oder Stacked-Crystal-Filter wenigstens zwei Elektroden auf. Die Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf zwei übereinander gelagerte Elektroden, nämlich eine untere Elektrode 15 und eine obere Elektrode 16. Die beiden Elektroden können jede beliebige geometrische Form aufweisen. Als "effektive Resonatorfläche" wird im Rahmen der 10 vorliegenden Erfindung die Fläche der Elektroden bezeichnet, die sich bei einer Projektion der beiden Elektroden in eine Ebene als der überlappende Bereich der Elektroden ergibt. Die effektive Resonatorfläche der Elektroden 15 und 16 ist in Fig. 3 schraffiert dargestellt. Aufgrund der grundsätzlich 15 beliebigen Form der Elektroden 15 und 16 ergibt sich für die effektive Resonatorfläche eine beliebig geformte ebene Fläche.

Jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator weist somit eine bestimmte effektive Resonatorfläche auf, die durch ihre geometrische Form und durch ihren Flächeninhalt gekennzeichnet ist. Zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren mit unterschiedlicher effektiver Resonatorfläche können sich also grundsätzlich in der Flächenform der effektiven Resonatorfläche und/oder im Flächeninhalt der effektiven Resonatorfläche unterscheiden.

Ein Bulk-Acoustic-Wave-Filter setzt sich aus einer

Mehrzahl von parallel bzw. in Reihe geschalteten BulkAcoustic-Wave-Resonatoren oder Stacked-Crystal-Filter
zusammen. Im folgenden wird der Begriff "Bulk-Acoustic-WaveResonator" synonym für die beiden, in den Figuren 1 und 2
gezeigten, Vorrichtungen, nämlich Bulk-Acoustic-Wave
Resonator und Stacked-Crystal-Filter, gebraucht.

4

Das Design der Bulk-Acoustic-Wave-Filter wird in der Regel derart gestaltet, dass die in Serie geschalteten Resonatoren eine serielle Resonanz aufweisen, deren Frequenz möglichst genau der gewünschten Frequenz des Filters entspricht, während entsprechend die parallel geschalteten Resonatoren eine parallele Resonanz aufweisen, deren Frequenz ebenfalls möglichst genau der gewünschten Frequenz des Filters entspricht.

Dirchlassbereich der Filter nachteilig auswirkt. Vor allem wird das Stehwellenverhältnis verschlechtert bzw. die Phasenkurve der Filter verzerrt, wodurch z.B. in Receiver-Frontends die Bedingung konstanter Gruppenlaufzeit innerhalb eines Sendekanals verletzt wird.

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Ansätze bekannt, mit denen eine Unterdrückung der Störmoden versucht wird. Die US 5,903,087 offenbart Bulk-Acoustic-Wave25 Resonatoren, deren Elektroden an den Rändern nicht geglättet sind, sondern vielmehr in Form eines Zufallsmusters angerauhte Ränder aufweisen, wobei die Rauhigkeit ungefähr die Dimension der Wellenlängen der Störmoden aufweist. Die Störmoden werden dadurch unterdrückt und sind in der
30 Impedanzkurve weniger sichtbar. Allerdings treten bei diesem Verfahren starke Energieverluste auf, die sich auf die Güte der Hauptresonanzen auswirken.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 35 zugrunde, Bulk-Acoustic-Wave-Filter zur Verfügung zu stellen, bei denen die Störmoden gedämpft werden, aber gleichzeitig

5

die Nutzresonanz nur unwesentlich oder überhaupt nicht beeinflusst wird.

Diese Aufgabe wird durch den Bulk-Acoustic-Wave-Filter gemäß unabhängigem Patentanspruch 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen, Ausgestaltungen und Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen, der Beschreibung und den beiliegenden Zeichnungen.

10

15

20

25

30

35

Der erfindungsgemäße Bulk-Acoustic-Wave-Filter umfasst wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-Wave-Resonator wenigstens eine erste Elektrode, eine piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode umfasst. Wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren weisen effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Durch diese Gestaltung der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren lassen sich Störmoden optimal unterdrücken, ohne dass dabei das Impedanzniveau des Filter beeinflusst wird.

Da jeder Resonator andere Störmodenfrequenzen aufweist, kommt es durch die Verschaltung im Filter zu einem Mittelungseffekt. Dadurch macht sich die einzelne Störmode im Filterresponse im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten Bulk-Acoustic-Wave-Filtern mit Resonatoren gleicher Fläche nicht so stark bemerkbar. Allerdings beeinflussen unterschiedliche Flächeninhalte der effektiven Resonatorflächen auch das Impedanzniveau der Resonatoren. Sie sind daher durch Impedanzanpassbedingungen im Filter in einem gewissen Rahmen festgelegt.

Sämtliche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beruhen also darauf, dass nicht versucht wird, den einzelnen Bulk-Acoustic-Wave-Resonator störmodenfrei zu machen, was technisch schwierig ist und möglicherweise Resonator-Perfomance kostet, sondern darauf, dass erst mit der

6

Verschaltung im Filter eine Verwaschung von vielen Störmoden bei unterschiedlichen Frequenzen eintritt und damit die Transmissionsfunktion des Filters den erwünschten glatten Verlauf erhält.

5

10

15

20

25

30

35

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren des Bulk-Acoustic-Wave-Filters effektive Resonatorflächen auf, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weisen wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Aspektverhältnis auf. Das Aspektverhältnis beeinflusst die Lage der Störmoden in ähnlicher Weise wie sie durch den Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren beeinflusst wird, verändert aber das Impedanzniveau nicht. Die Störmoden werden somit wirkungsvoll unterdrückt, wobei gleichzeitig die Nutzresonanz unverändert bleibt.

Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei der alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Aspekt-Verhältnissen aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Ebenfalls bevorzugt wird eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gemäß der wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit einer nicht-rechtwinkligen Form aufweisen. Unter einer nicht-rechtwinkligen Form der effektiven Resonatorfläche eines Bulk-Acoustic-Wave-Resonators wird eine Form verstanden, bei der die Winkel zwischen den Begrenzungslinien der effektiven Resonatorfläche ungleich 90° sind. Durch diese Ausgestaltung

7

der Resonatoren gelingt eine gute Unterdrückung der Störmoden.

Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform, bei der alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit einer nicht-rechtwinkligen Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Beste Resultate lassen sich mit Bulk-Acoustic-WaveFiltern erzielen, bei denen wenigstens zwei der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit
unterschiedlichem Flächeninhalt und gleichzeitig
unterschiedlichem Aspektverhältnis aufweisen. Durch passende
Wahl des Flächeninhalts der effektiven Resonatorfläche und
gleichzeitige Variation des Aspektverhältnisses der
effektiven Resonatorfläche lassen sich sowohl
Impedanzanpassungsbedingungen erfüllen als auch Störmoden
optimal unterdrücken.

20

25

30

Eine weitere Verbesserung wird mit Ausführungsformen erzielt, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Flächeninhalten und unterschiedlichen Aspektverhältnissen aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Ebenfalls bevorzugt werden Bulk-Acoustic-Wave-Filter, wobei wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Aspektverhältnis und gleichzeitig nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen

8

und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, gemäß denen wenigstens zwei Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eines Bulk-Acoustic-Wave-Filters eine effektive Resonatorfläche mit unterschiedlichem Flächeninhalt, unterschiedlichen Aspektverhältnis und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

10

15

20

25

30

35

Ebenfalls besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen mit unterschiedlichen Flächeninhalten, unterschiedlichen Aspektverhältnissen und nicht-rechtwinkliger Form aufweisen. Dadurch können Störmoden noch stärker unterdrückt werden.

Besonders gute Störmodenunterdrückung wird erreicht, wenn das Aspektverhältnis der effektiven Resonatorflächen der erfindungsgemäßen Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren zwischen 1:1 und 1:5 liegt, insbesondere zwischen 1:1.5 und 1:3.

Weisen die effektiven Resonatorflächen der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren unterschiedlichen Flächeninhalt
auf, so wird bevorzugt, dass sich der Flächeninhalt der
effektiven Resonatorflächen um wenigstens 5 % voneinander
unterscheidet, insbesondere um wenigstens 10 %. Ganz
besonders bevorzugt wird, dass sich der Flächeninhalt der
effektiven Resonatorflächen um wenigstens 20 % voneinander
unterscheidet, insbesondere um wenigstens 50 %.

Die Bulk-Acoustic-Wave-Filter werden durch Verschaltung von Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren hergestellt. Das Prinzip, den Flächeninhalt der effektiven Resonatorfläche, das Aspektverhältnis der effektiven Resonatorfläche und/oder den Winkel zwischen den Begrenzungslinien der effektiven Resonatorflächen zu variieren, um Störmoden im Filterresponse

WO 02/43243

25

9

zu unterdrücken, lässt sich auf jede Filtertopologie anwenden. Gemäß besonders bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung erfolgt die Verschaltung in Form eines 1½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 2-stufigen Leiterfilters, in Form eines 2½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 3½-stufigen Leiterfilters oder in Form eines 3½-stufigen Leiterfilters, wobei 3, 4, 5, 6 oder 7 Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren verschaltet werden.

Ebenfalls bevorzugt wird die Verschaltung der BulkAcoustic-Wave-Resonatoren zu einem Bulk-Acoustic-Wave-Filter
in Form eines 1-stufigen balanced Filters, in Form eines 2stufigen balanced Filters oder in Form eines 3-stufigen
balanced Filters. Es werden in diesem Fall 4, 8 oder 12 BulkAcoustic-Wave-Resonatoren verschaltet.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 8 näher dargestellt. Es zeigen:

- 20 Fig. 1 einen aus dem Stand der Technik bekannten Bulk-Acoustic-Wave-Resonator;
 - Fig. 2 einen aus dem Stand der Technik bekannten Stacked-Crystal-Filter;
- Fig. 3 zwei übereinandergelagerte Elektroden und deren effektive Resonatorfläche;
- Fig. 4 einen aus dem Stand der Technik bekannten 2-30 stufigen Leiterfilter;
- 2-stufigen erfindungsgemäßen Fig. 5 einen Bulk-Acousticaufgebaut Leiterfilter aus unterschiedlichem mit Wave-Resonatoren effektiven Flächeninhalt der 35 Resonatorflächen;

10

- Fig. 6 einen erfindungsgemäßen 2-stufigen
 Leiterfilter aufgebaut aus Bulk-AcousticWave-Resonatoren mit unterschiedlichem
 Aspektverhältnis der effektiven
 Resonatorflächen;
- Fig. 7 Auftragung (schematisch) des Streuparameters von Eingang zu Ausgang (S_{12}) gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 identischen quadratischen Einzelresonatoren (Stand der Technik);
- Fig. 8 Auftragung (schematisch) des Streuparameters von Eingang zu Ausgang (S₁₂) gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 Einzelresonatoren mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen der effektiven Resonatorflächen (Erfindung).
- Fig. 4 zeigt einen aus dem Stand der Technik bekannten 2-stufigen Leiterfilter mit 4 gleich großen quadratischen Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren, die eine identische effektive Resonatorfläche aufweisen. Die Störmoden jedes Einzelresonators treten an den gleichen Frequenzstellen auf und sind entsprechend im elektrischen Response des Filters zu finden.
- Fig. 5 zeigt einen 2-stufigen Leiterfilter mit 4 BulkAcoustic-Wave-Resonatoren mit effektiven Resonatorflächen,

 die unterschiedliche Flächeninhalte aufweisen. Jeder
 Resonator hat unterschiedliche Störmodenfrequenzen. Durch die
 Verschaltung im Filter kommt es zu einem Mittelungseffekt,
 wodurch sich die einzelne Störmode im Filterresponse im
 Vergleich zu der in Fig. 4 gezeigten Ausführungform des

 Standes der Technik nicht so stark bemerkbar macht.

11

Fig. 6 zeigt einen 2-stufigen Leiterfilter mit 4 BulkAcoustic-Wave-Resonatoren mit effektiven Resonatorflächen,
die zwar gleichen Flächeninhalt, aber unterschiedliche
Aspektverhältnisse aufweisen. Das Aspektverhältnis
beeinflusst die Lage der Störmoden in ähnlicher Weise wie bei
der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform, wobei aber
gleichzeitig das Impedanzniveau des Filters unverändert
bleibt.

Die Figuren 7 und 8 zeigen jeweils eine schematische Auftragung des Streuparameters von Eingang zu Ausgang S_{12} in logarithmischer Skala gegen die Frequenz für einen 3-stufigen Leiterfilter mit 6 Einzelresonatoren. Zur Bestimmung von S_{12} wurde in bekannter Weise durch einen Frequenzanalysator die Streumatrix des Leiterfilters ermittelt.

In der Fig. 7 ist die Kennlinie eines aus dem Stand der Technik bekannten Leiterfilters, der aus 6 gleichen quadratischen Einzelresonatoren mit identischen effektiven Resonatorflächen besteht, dargestellt. Die Kennlinie zeigt ein "Rauschen" im Passband, das von spurious modes der Einzelresonatoren verursacht ist.

20

25

30

35

In der Fig. 8 ist die Kennlinie eines Leiterfilters gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt, der die gleiche Topologie aufweist wie der Leiterfilter, dessen Kennlinie in Fig. 7 dargestellt ist, allerdings weisen die effektiven Resonatorflächen der 6 Einzelresonatoren unterschiedliche Aspektverhältnisse auf. Das Rauschen im Passband mittelt sich spurious heraus, die da modes der der aus Kurve Einzelresonatoren an verschiedenen Frequenzpunkten auftreten.

Ähnliche Ergebnisse liefert ein Vergleich von einerseits Filtern mit Einzelresonatoren mit quadratischen effektiven Resonatorflächen und andererseits Filtern, bei denen die effektiven Resonatorflächen der Einzelresonatoren nicht rechtwinklige Form aufweisen (Winkel zwischen den

12

Begrenzungslinien der effektiven Resonatorflächen der Einzelresonatoren ungleich 90°). Hier wird ein deutlich geringeres Rauschen im Passband für den Filter festgestellt, dessen Einzelresonatoren effektive Resonatorflächen mit nicht-rechtwinkliger Form aufweisen.

WO 02/43243 PCT/E

13

PCT/EP01/12825

Patentansprüche

- 1. Bulk-Acoustic-Wave-Filter umfassend wenigstens zwei BulkAcoustic-Wave-Resonatoren, wobei jeder Bulk-Acoustic-WaveResonator wenigstens eine erste Elektrode, eine
 piezoelektrische Schicht und eine zweite Elektrode
 umfasst,
- dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen aufweisen, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
- 2. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass alle Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren effektive Resonatorflächen aufweisen, die sich in Flächenform und/oder Flächeninhalt unterscheiden.
- 3. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 1 oder 2, da durch gekennzeichnet, dass die effektiven Resonatorflächen von wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren ein unterschiedliches Aspektverhältnis aufweisen.

25

4. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die effektiven Resonatorflächen aller Bulk-Acoustic-WaveResonatoren unterschiedliche Aspektverhältnisse aufweisen.

30

- 5. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, dass die effektiven Resonatorflächen von wenigstens zwei der Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren eine nicht-rechtwinklige Form aufweisen.

14

6. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die effektiven Resonatorflächen aller Bulk-Acoustic-WaveResonatoren eine nicht-rechtwinklige Form aufweisen.

5

10

15

- 7. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Aspekt-Verhältnis der effektiven Resonatorflächen
- 8. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
 das Aspekt-Verhältnis der effektiven Resonatorflächen
 zwischen 1:1.5 und 1:3 liegt.
- 9. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, dass

 sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um
 wenigstens 5 % voneinander unterscheidet, insbesondere um
 wenigstens 10 %.
 - 10.Bulk-Acoustic-Wave-Filter Anspruch 9,

zwischen 1:1 und 1:5 liegt.

- dadurch gekennzeichnet, dass sich der Flächeninhalt der effektiven Resonatorflächen um wenigstens 20 % voneinander unterscheidet, insbesondere um wenigstens 50 %.
- 30 11.Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 - dadurch gekennzeichnet, dass die Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren in Form eines 1½stufigen Leiterfilters, in Form eines 2-stufigen
- Leiterfilters, in Form eines 2½-stufigen Leiterfilters, in Form eines 3-stufigen Leiterfilters oder in Form eines 3½-stufigen Leiterfilters verschaltet sind.

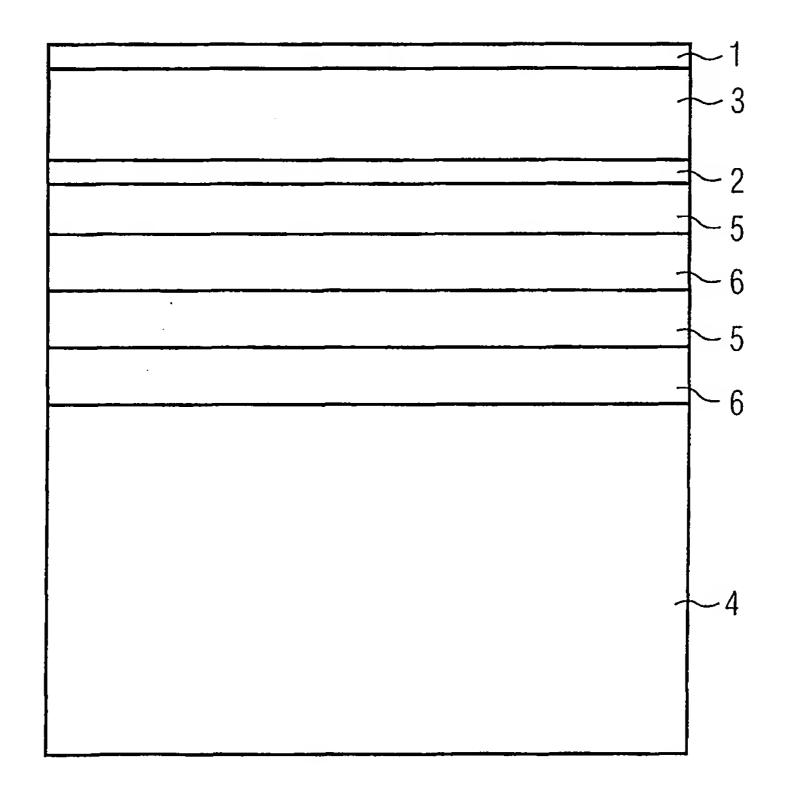
15

12. Bulk-Acoustic-Wave-Filter nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

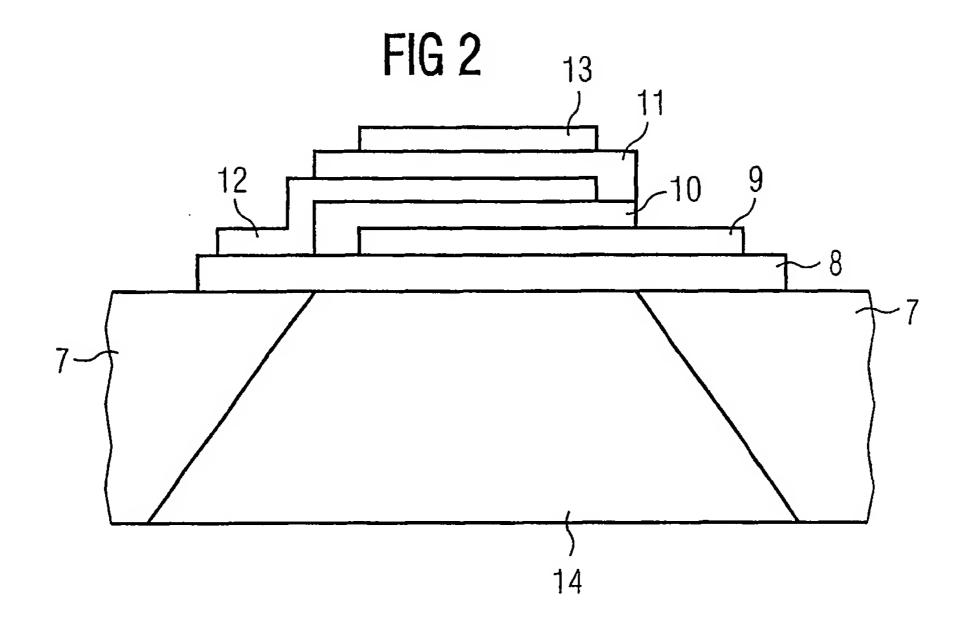
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bulk-Acoustic-Wave-Resonatoren in Form eines 1stufigen balanced Filters, in Form eines 2-stufigen
balanced Filters oder in Form eines 3-stufigen balanced
Filters verschaltet sind.

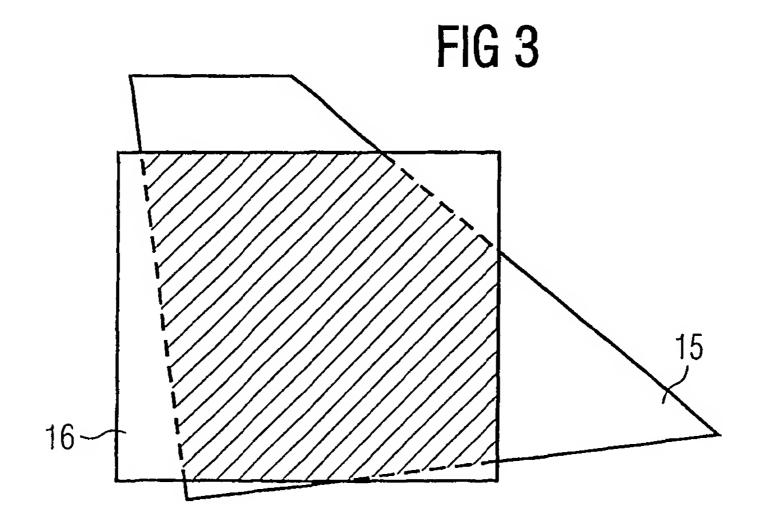
1/4

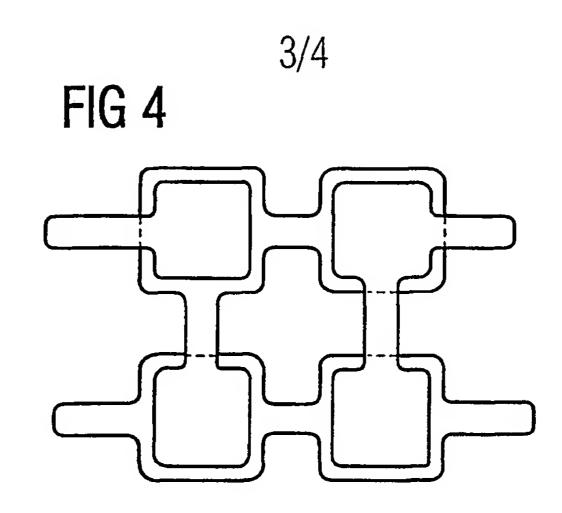
FIG 1

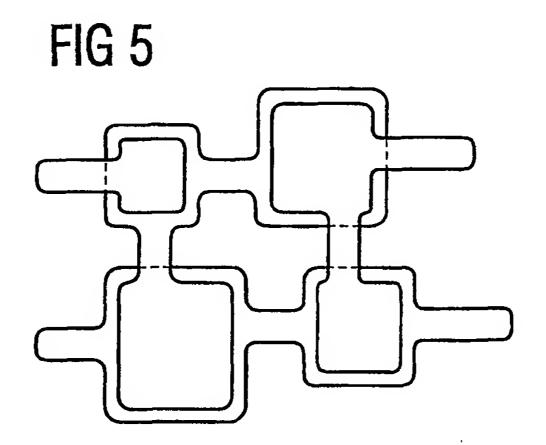


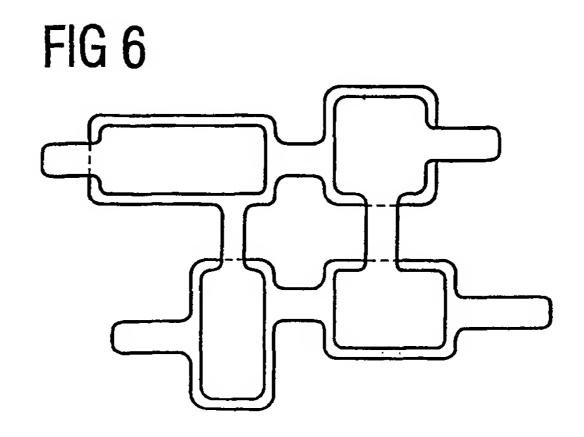
2/4



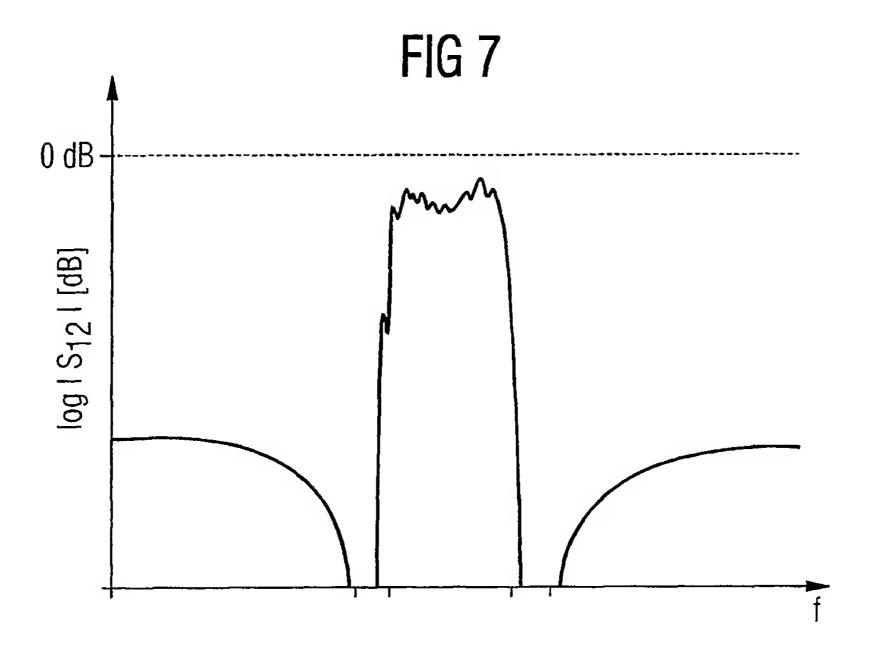


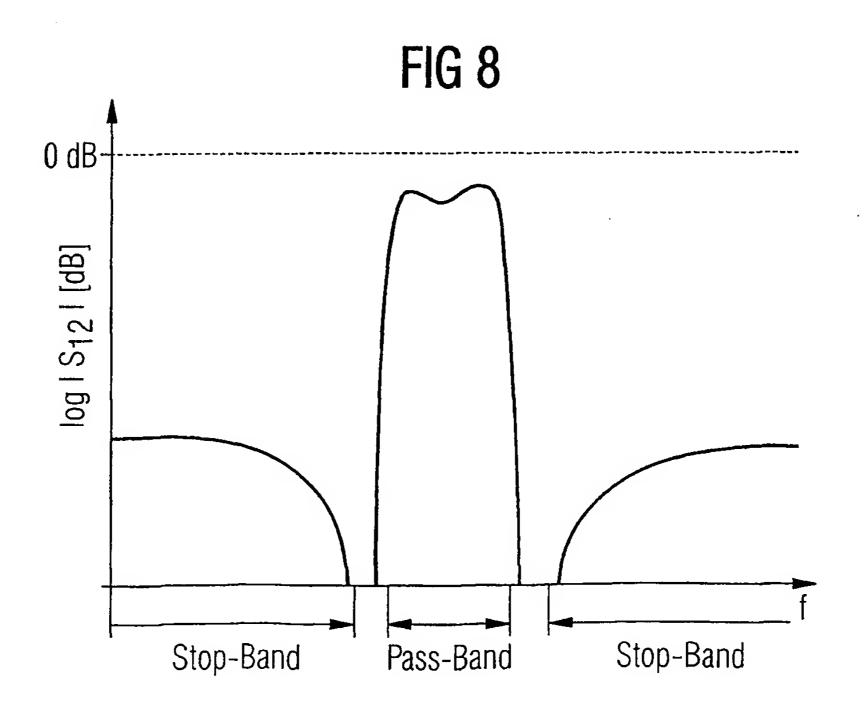






4/4





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

li tional Application No PCT/EP 01/12825

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H03H9/58					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	tion and IPC			
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)			
IPC 7					
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ich documents are included in the flelds se	earched		
Documenta					
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)		
EPO-In	ternal				
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	went passages	Relevant to claim No.		
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rele	vaн раззауез	Tiolevant to diaminto.		
Х	US 5 572 173 A (OGAWA TATSUO ET AL) 5 November 1996 (1996-11-05)		1-3,7,8		
Α	column 4, line 59 -column 5, line	28;	4,9,10		
	figures 4-6				
Α	US 4 317 093 A (LUNGO ANTONIO)		4,5		
	23 February 1982 (1982-02-23) column 2, line 35,36				
:	claim 35				
			•		
			•		
Funt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.		
° Special categories of died documents: "T" later document published after the International filing date					
or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention					
E earlier document but published on or after the International filling date "X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to					
L document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another *Y* document of particular relevance; the claimed invention					
citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "C" document is combined with one or more other such document of the means of the means of the considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is					
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family					
<u></u>	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report		
1	0 April 2002	19/04/2002			
Name and I	mailing address of the ISA	Authorized officer			
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Connictors C			
	Fax: (+31-70) 340-3016	Coppieters, C			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir_i :ional Application No PCT/EP 01/12825

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5572173	Α	05-11-1996	JP JP	7226651 A 7226652 A	22-08-1995 22-08-1995
US 4317093	A	23-02-1982	CA JP	1153077 A1 55137712 A	30-08-1983 27-10-1980

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen
PCT/EP 01/12825

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H03H9/58					
		-: Clubing and dor IOV			
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass RCHIERTE GEBIETE	sinkation und der iPK			
•	ter Mindestprüfsloff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol	e)			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow				
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete Su	chbegriffe)		
EPO-In	ternal				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	·			
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.		
Х	US 5 572 173 A (OGAWA TATSUO ET AL)		1-3,7,8		
A	5. November 1996 (1996-11-05) Spalte 4, Zeile 59 -Spalte 5, Zeile 28; Abbildungen 4-6		4,9,10		
A	US 4 317 093 A (LUNGO ANTONIO) 23. Februar 1982 (1982-02-23) Spalte 2, Zeile 35,36 Anspruch 35		4,5		
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie					
"A' Veröffe aber n "E' ätteres Anme "L' Veröffe scheir ander soll od ausge "O' Veröffe eine E "P' Veröffe dem b	Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : A' Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E' ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden Ist L' Veröffentlichung, die geetgnet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen Im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen beziehl P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem Prioritätsdatum veröffentlichungen ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prioritätsdatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Veröffentlichung von besonderer				
	Abschlusses der internationalen Recherche O April 2002	19/04/2002			
	0. April 2002 Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächligter Bediensteter			
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nt. Fax: (+31–70) 340–3016	Coppieters, C			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aklenzeichen
PCT/EP 01/12825

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokums		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5572173	A	05-11-1996	JP JP	7226651 A 7226652 A	22-08-1995 22-08-1995
US 4317093	Α	23-02-1982	CA , JP	1153077 A1 55137712 A	30-08-1983 27-10-1980